

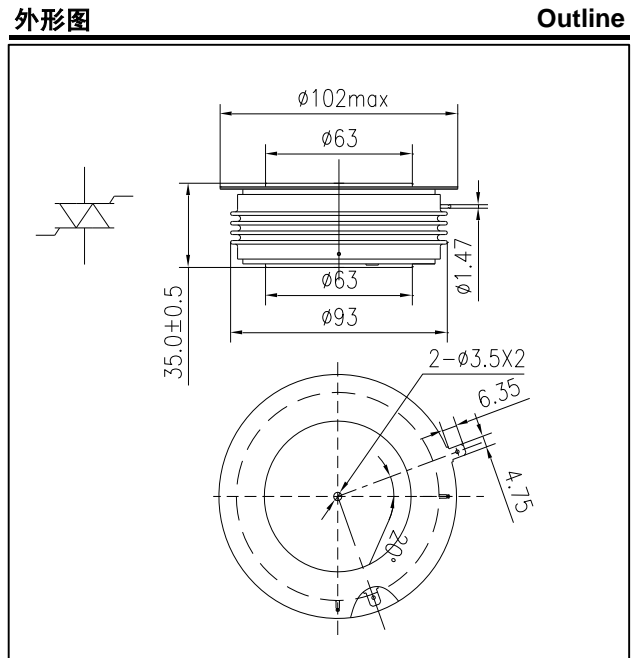
关键参数	Key Parameters	
V_{DSM}	3600~4200	V
$I_{T(AV)}$	1000	A
$I_{T(RMS)H}$	1570	A
I_{TSM}	15	kA
V_{TO}	1.05	V
r_T	0.50	mΩ

应用	Applications
● 牵引传动	Traction drive
● 电机驱动	Motor drive
● 工业变流器	Industry converter

特点	Features
● 两个晶闸管集成在一个硅片上	Two thyristors integrated into one wafer
● 平板压装、双面冷却	Double-side cooling
● 大功率容量	High power capability
● 低损耗	Low loss

热和机械数据		Thermal & Mechanical Data			
符号	参数名称	最小	典型	最大	单位
R_{thJC}	结壳热阻	-	-	0.022	K/W
R_{thCH}	接触热阻	-	-	0.005	K/W
T_{vj}	内部等效结温	-40	-	125	°C
T_{stg}	贮存温度	-40	-	140	°C
F	紧固力	-	50	-	kN
m	质量	-	1.25	-	kg

电压额定值		Voltage Ratings
器件型号	断态重复峰值电压 电压 V_{DRM}	测试条件
KB _x 2200-36	3600	$T_{vj} = 25, 125\text{ °C}$
KB _x 2200-38	3800	$I_{DRM} \leq 400\text{ mA}$
KB _x 2200-40	4000	门极断路
KB _x 2200-42	4200	$V_{DM} = V_{DRM}$
		$t_p = 10\text{ ms}$
		断态重复峰值电压: $V_{DSM} = V_{DRM}$



电流额定值		Current Ratings				
符号	参数名称	条件	最小	典型	最大	单位
$I_{T(AV)}$	通态平均电流	正弦半波, $T_C = 70\text{ °C}$	-	-	1000	A
$I_{T(RMS)H}$	通态方均根电流(正弦半波)	正弦半波, $T_C = 70\text{ °C}$	-	-	1570	A
$I_{T(RMS)F}$	通态方均根电流(正弦全波)	正弦全波, $T_C = 70\text{ °C}$	-	-	2219	A
I_{TSM}	通态不重复浪涌电流	$T_{vj} = 125\text{ °C}$, 正弦半波, 底宽10ms, $V_R = 0$	-	-	15.0	kA
I^2t	电流平方时间积	正弦波, 10ms	-	-	113	$10^4\text{ A}^2\text{ s}$

特性值

Characteristics

符号	参数名称	条件	最小	典型	最大	单位
V_{TM}	通态峰值电压	$T_{vj} = 125\text{ }^{\circ}\text{C}$, $I_{TM} = 1000\text{ A}$	-	-	1.55	V
I_{DRM}	断态重复峰值电流	$T_{vj} = 25\text{ }^{\circ}\text{C}$, $125\text{ }^{\circ}\text{C}$, V_{DRM} , 门极断路	-	-	400	mA
V_{TO}	门槛电压	$T_{vj} = 125\text{ }^{\circ}\text{C}$	-	-	1.05	V
r_T	斜率电阻	$T_{vj} = 125\text{ }^{\circ}\text{C}$	-	-	0.5	m Ω
I_H	维持电流	$T_{vj} = 25\text{ }^{\circ}\text{C}$	-	-	200	mA
I_L	擎住电流	$T_{vj} = 25\text{ }^{\circ}\text{C}$	-	-	1000	mA

动态参数

Dynamic Parameters

符号	参数名称	条件	最小	典型	最大	单位
dv/dt	断态电压临界上升率	$T_{vj} = 125\text{ }^{\circ}\text{C}$, 门极断路电压线性上升到 $0.67 V_{DRM}$	1000	-	-	V/ μ s
di/dt	通态电流临界上升率	$T_{vj} = 125\text{ }^{\circ}\text{C}$, $V_{DM} = 0.67 V_{DRM}$, $f = 50\text{ Hz}$ $I_{TM} = 1000\text{ A}$, $I_{FG} = 2\text{ A}$, $tr = 0.5\text{ }\mu$ s	-	-	150	A/ μ s
t_q	关断时间	$T_{vj} = 125\text{ }^{\circ}\text{C}$, $V_{DM} = 0.67 V_{DRM}$, $I_T = 2000\text{ A}$ $dv/dt = 20\text{ V}/\mu$ s, $V_R = 200\text{ V}$, $-di/dt = 1.5\text{ A}/\mu$ s	-	700	-	μ s
Q_{rr}	反向恢复电荷	$T_{vj} = 125\text{ }^{\circ}\text{C}$, $-di/dt = 1.5\text{ A}/\mu$ s, $I_T = 2000\text{ A}$, $V_R = 200\text{ V}$	-	2300	-	μ C
dv/dt_{com}	换向电压临界上升率	$T_{vj} = 125\text{ }^{\circ}\text{C}$, $V_R \leq 0.67 V_{DRM}$	-	-	500	V/ μ s

门极特性

Gate Parameters

符号	参数名称	条件	最小	典型	最大	单位
I_{GT}	门极触发电流	$T_{vj} = 25\text{ }^{\circ}\text{C}$	-	-	300	mA
V_{GT}	门极触发电压	$T_{vj} = 25\text{ }^{\circ}\text{C}$	-	-	3	V
V_{GD}	门极不触发电压	$T_{vj} = 125\text{ }^{\circ}\text{C}$, $V_D = 0.4V_{DRM}$	0.3	-	-	V
V_{FGM}	门极正向峰值电压		-	-	12	V
V_{RGM}	门极反向峰值电压		-	-	5	V
I_{FGM}	门极正向峰值电流		-	-	4	A
P_{GM}	门极峰值功率		-	-	20	W
$P_{G(AV)}$	门极平均功率		-	-	4	W

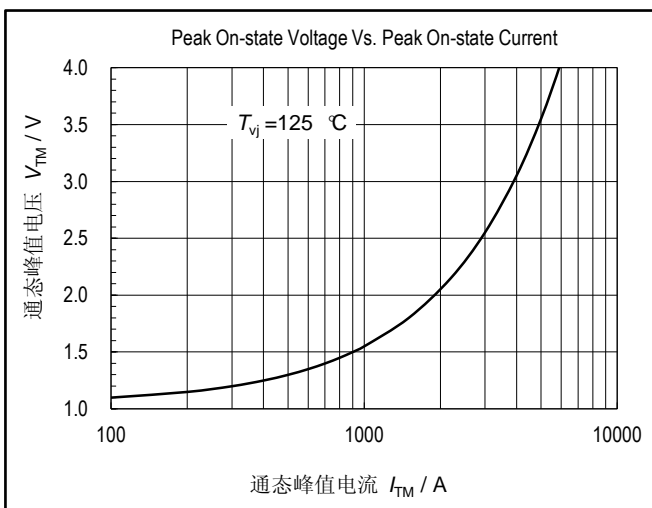


图1. 通态伏安特性曲线

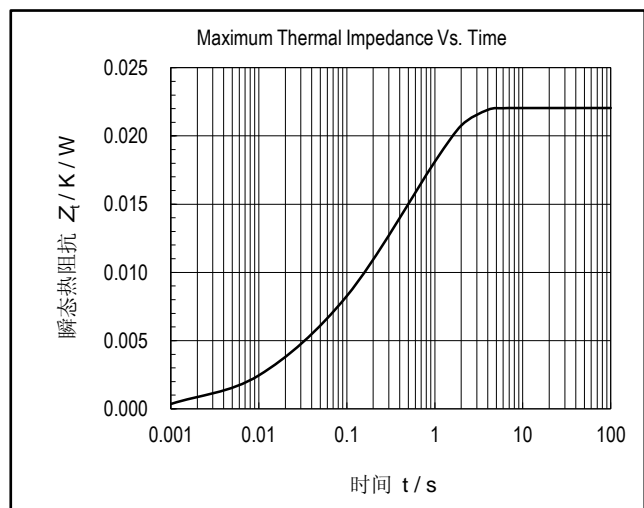


图2. 瞬态热阻抗曲线

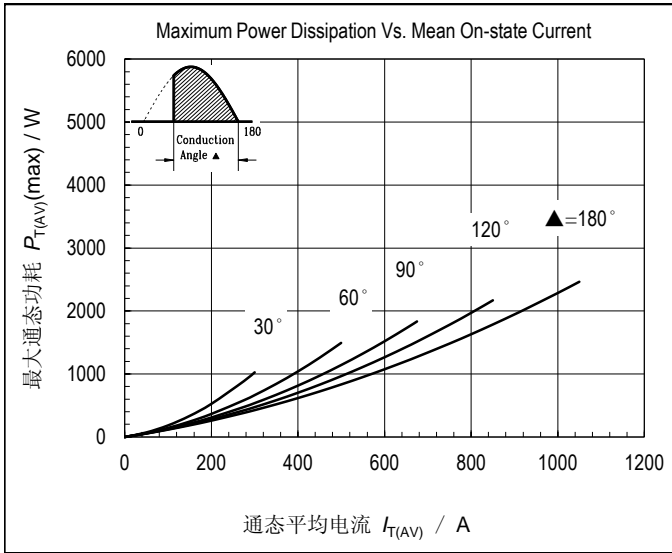


图3. 最大功耗与通态平均电流的关系曲线

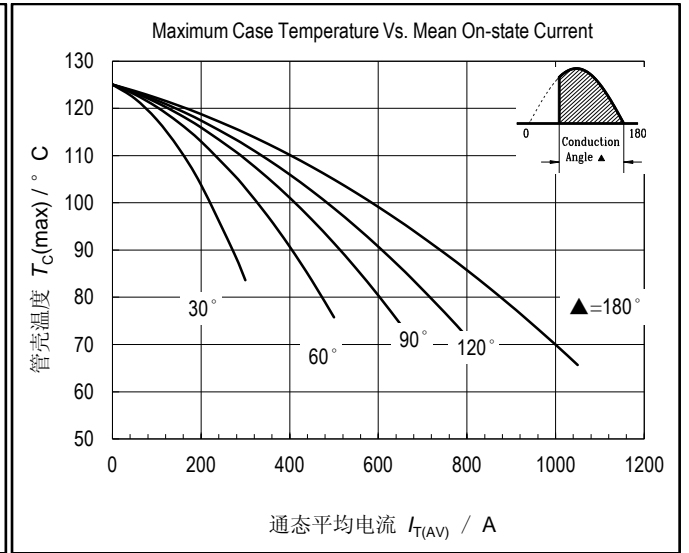


图4. 管壳温度与通态平均电流的关系曲线

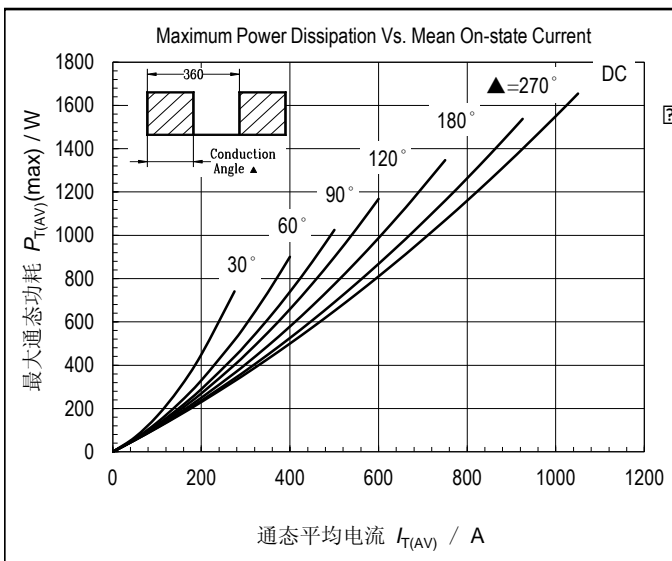


图5. 最大通态功耗与通态平均电流的关系曲线

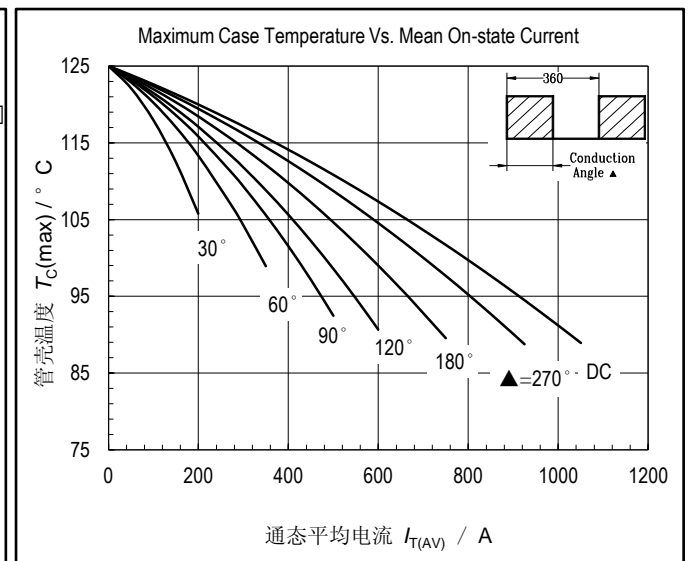


图6. 管壳温度与通态平均电流的关系曲线

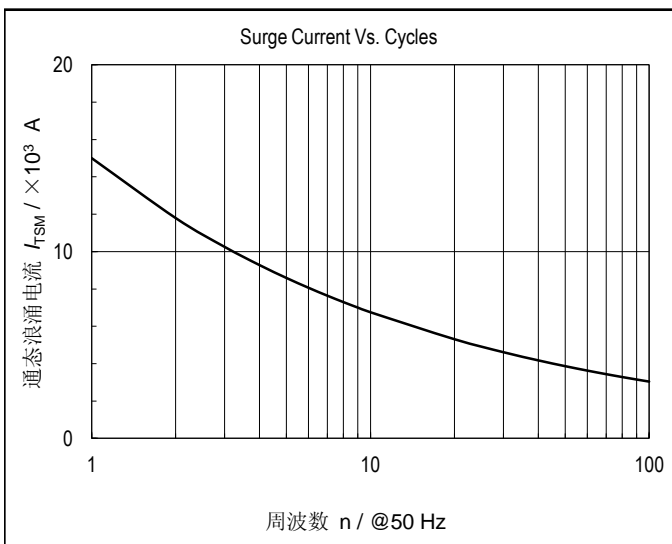


图7. 通态浪涌电流与周波数的关系曲线

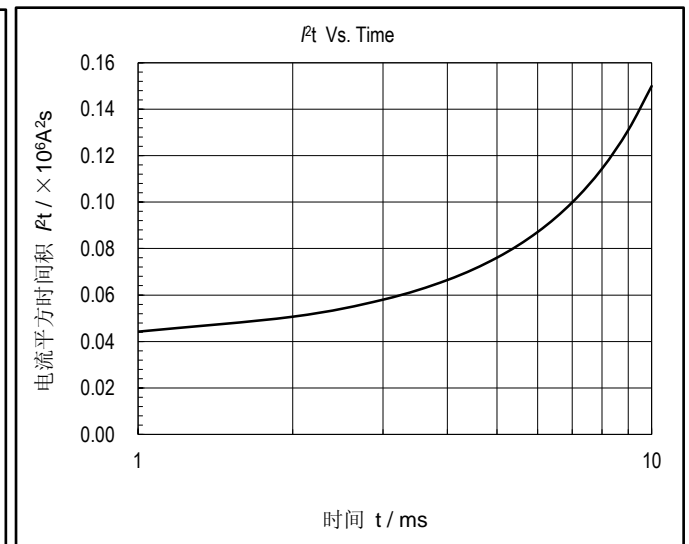


图8. I^2t 特性曲线

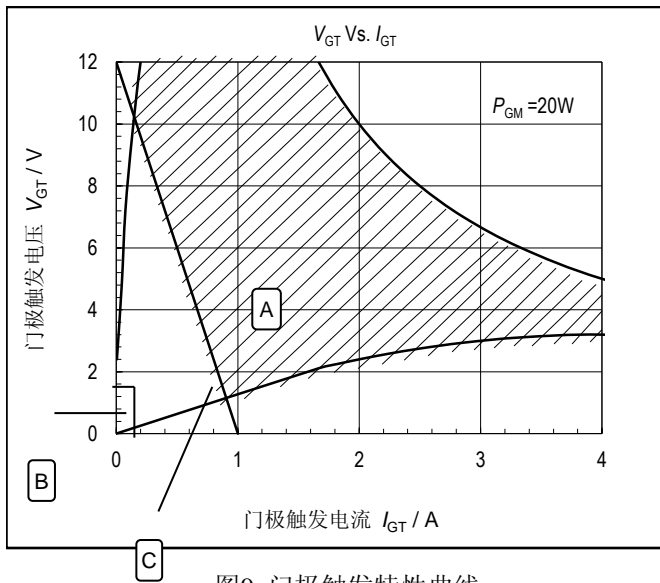


图9. 门极触发特性曲线

A为可靠触发区，
 B为不可靠触发区。
 C为建议采用的门极负载线。

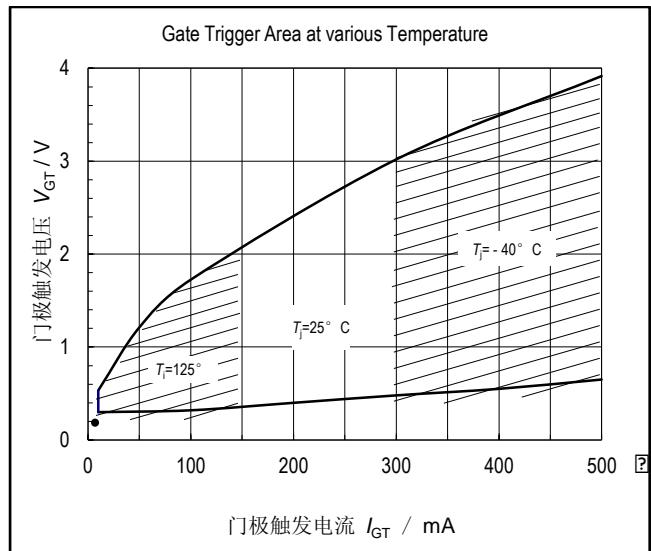


图10. 不同结温下的门极触发区

A is Recommended Triggering Area.
 B is Unreliable Triggering Area.
 C is Recommended Gate Load Line.

株洲中车时代电气股份有限公司半导体事业部

Semiconductor Business Unit, Zhuzhou CRRC Times Electric Co., Limited

地 址	Address	湖南省株洲市田心工业园
邮 编	Zipcode	412001
电 话	Telephone	0731 - 28498268, 28498124
传 真	Fax	0731 - 28498851, 28498494
电子邮箱	Email	sbu@crrecic.cc
网 址	Web Site	www.sbu.crrecic.cc